

Сведения об официальном оппоненте

по диссертации Иванова Владимира Викторовича «Исследование эффектов оптической близости и разработка методов их коррекции для критических литографических слоев технологии производства СБИС проектных норм 65 нм», представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.27.01 — «Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах».

Ф.И.О. полностью	Петросянц Константин Орестович
Гражданство	РФ
Ученая степень	Доктор технических наук
Шифр и название специальности по которой защищена диссертация оппонента, отрасль науки	специальность (05.27.01) Твердотельная электроника, радиоэлектронные компоненты, микро- и нанoeлектроника, приборы на квантовых эффектах
Ученое звание	Профессор
Основное место работы:	
Полное наименование организации в соответствии с уставом	Московский институт электроники и математики им. А.Н. Тихонова Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики
Сокращенное наименование организации	МИЭМ НИУ ВШЭ
Ведомственная принадлежность организации	Министерство науки и высшего образования РФ
Почтовый адрес организации	123458, г. Москва, ул. Таллинская, д. 34.
Телефон, факс, e-mail организации	Телефон, факс 8 (495) 916-88-29, +7 (495) 772-95-90, доб. 15208. E-mail: miem@hse.ru, kpetrosyants@hse.ru
Наименование подразделения организации	Департамент электронной инженерии
Должность в организации	Профессор-исследователь

Список основных публикаций по теме оппонируемой диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций):

1.	Petrosyants K. O., Denis S. Silkin, Popov D. Comparative Characterization of NWFET and FinFET Transistor Structures Using TCAD Modeling // Micromachines. 2022. Vol. 13. No. 8. Article 1293.
2.	K. O. Petrosyants, D. S. Silkin, D. A. Popov. Evaluation of the Effect of FinFET Structure Parameters on Electrical Characteristics Using TCAD Modeling Tools // Russian Microelectronics. 2022. Vol. 51. No. 8. P. 644-648.
3.	Petrosyants K. O., Sambursky L. M., Kozhukhov M., Ismail-zade M. R., Kharitonov I. A., Li B. SPICE Compact BJT, MOSFET and JFET Models for ICs Simulation in the Wide Temperature Range (from -200 °C to +300 °C) // IEEE Transactions on Computer-Aided Design of Integrated Circuits and Systems. 2021. Vol. 40. No. 4. P. 708-722.
4.	Wang Y., Liu F., Li B., Li B., Huang Y., Yang C., Zhang J., Wang G., Luo J., Han Z., Petrosyants K. O. Dependence of Temperature and Back-Gate Bias on Single-Event Upset Induced by Heavy Ion in 0.2- μm DSOI CMOS Technology // IEEE Transactions on Nuclear Science. 2021. Vol. 68. No. 8. P. 1660-1667.
5.	Petrosyants K. O., Popov D. Self-Heating Investigation in SOI MOSFET Structures with High Thermal Conductivity Buried Insulator Layers //2020, 36th Semiconductor Thermal Measurement, Modeling & Management Symposium (SEMI-THERM). San Jose, CA USA: IEEE, 2020. P. 56-60.
6.	Petrosyants K. O., Popov D. Comparison of Self-heating Effect in SOI MOSFETs with Various Configuration of Buried Oxide //Proc. of the 2nd International Conference on Microelectronic Devices and Technologies (MicDAT '2019). Barcelona: International Frequency Sensor Association (IFSA), 2019. P. 24-28.
7.	Adonin A. S., Petrosyants K. O., Popov D. Modeling of the Submicron MOSFETs Characteristics for UTSi Technology // Proceedings of SPIE. 2019. Vol. 11022. P. 1-6.
8.	Petrosyants K. O., Pugachev A. A., Kharitonov I. A. Universal physical model of low-power and long lifetime betavoltaic microbatteries // Proceedings of the Seventh European Conference on Renewable Energy Systems (ECRES2019). Madrid , 2019. P. 1-7.
9.	Konstantin O. Petrosyants, Nikita I. Ryabov. Quasi-3D Thermal Simulation of Multi-Chip Stack Embedding Package, // 2020, 26th International Workshop on Thermal Investigations of ICs and Systems (THERMINIC). IEEE, 2020. P. 1-7.
10.	Петросянц К. О., Харитонов И. А., Пугачев А. А. Расчет ВАХ бетавольтаических микробатарей с использованием универсальной TCAD модели // Наноиндустрия. Специальный выпуск: Международный форум "Микроэлектроника-2019". 5-я Международная научная конференция "Электронная компонентная база и микроэлектронные модули" Т. 1. Вып. 96. Рекламно-издательский центр "ТЕХНОСФЕРА", 2020. С. 291-294.

11.	Лебедев С. В., Петросянц К. О., Стахин В. Г., Харитонов И. А. Особенности моделирования субмикронных МОП-транзисторов для расчета низковольтных и микромощных КМОП СБИС // Наноиндустрия. 2018. № 82. С. 412-414.
12.	Петросянц К.О., Попов Д.А. Моделирование эффекта саморазогрева КНИ МОП-транзистора с различной конфигурацией скрытого оксида // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2018. Т. 23. № 5. С. 521-525.
13.	

«19» мая 2023 г.

/ Константин Орестович Петросянц

Сведения (подпись) Петросянца К.О. заверяю.

*Специалист по персоналу
Исмаилова А.В.
23.05.2023*



Печать организации